

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УР МИЭТ



А.Г. Балашов

«19» января 2026 г.

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

по приёму в магистратуру в 2026 году

Института интегральной электроники имени академика К.А. Валиева
по направлению подготовки 11.04.04 «Электроника и нанoeлектроника»
по образовательной программе
«Проектирование и технология устройств интегральной нанoeлектроники»
(очная форма обучения)

**по вступительному испытанию «Проектирование и технология устройств
интегральной нанoeлектроники»**

Москва 2026 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» (уровень магистратуры) утвержден приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 959 от 22 сентября 2017 г.

1.2. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает: 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере эксплуатации электронных средств).

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры:

- научно-исследовательская;
- проектно-конструкторская;
- научно-педагогическая.

1.4. Вступительные испытания при приеме в магистратуру по направлению подготовки 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» проводятся в форме собеседования.

Основной целью вступительного испытания является отбор абитуриентов, наиболее подготовленных к продолжению обучения в магистратуре высшего учебного заведения по направлению подготовки 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника».

Задачами вступительного испытания являются:

- определение соответствия научных интересов абитуриента и образовательной программы;
- оценка уровня знаний и умений в профессиональной области;
- выявление степени подготовленности к продолжению обучения в магистратуре.

2. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

В соответствии с Правилами приёма в магистратуру при поступлении на образовательную программу «Проектирование и технология устройств интегральной нанoeлектроники» установлено следующее максимальное количество баллов за индивидуальные достижения (ИД):

- максимальное количество баллов, которое может получить поступающий за ИД в сумме – 50 баллов.
- максимальное количество баллов, которое может получить поступающий за определенную категорию ИД и(или) за определенный вид ИД указано в таблице 1.

Таблица 1 — Учитываемые индивидуальные достижения

№ п/п	Вид ИД	Тип подтверждающих документов	Документы для подтверждения наличия ИД	Оценка ИД
Категория «Диплом о профессиональном образовании с отличием или медалью»				10 баллов
1.	Наличие диплома с отличием, соответствующего направлениям подготовки УГН 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи»	Диплом бакалавра с отличием Диплом специалиста с отличием Диплом магистра с отличием	Необходимо предоставить скан-копию или фотографии лицевого разворота диплом о высшем образовании, а также всех страниц приложения к диплому	10 баллов
Категория «Наличие дополнительного образования, соответствующего конкурсному профилю»				10 баллов
2.	Наличие свидетельств, подтверждающих квалификацию не ниже 5 уровня в рамках профессиональных стандартов	Документ о наличии дополнительного образования, соответствующего конкурсному профилю	Необходимо предоставить скан-копию или фотографию свидетельства	не более 10 баллов, по 5 баллов за одно
3.	Наличие сертификатов о дополнительном образовании	Документ о наличии дополнительного образования, соответствующего конкурсному профилю	Необходимо предоставить скан-копию или фотографию сертификата	не более 6 баллов, по 2 балла за один
4.	Наличие пройденной программы повышения квалификации	Документ о наличии дополнительного образования, соответствующего конкурсному профилю	Необходимо предоставить скан-копию или фотографию удостоверения о повышении квалификации	не более 10 баллов, по 5 баллов за одно

5.	Наличие пройденной программы профессиональной переподготовки	Документ о наличии дополнительного образования, соответствующего конкурсному профилю	Необходимо предоставить скан-копию или фотографию диплома о профессиональной переподготовке, а также всех страниц приложения к диплому	не более 10 баллов, по 5 баллов за один
Категория «Служба добровольцем в зоне СВО»				25 баллов
6.	Участие в СВО	Документ, подтверждающий принадлежность к гражданам, призванным на военную службу по мобилизации или заключившие контракт, при условии их участия в СВО	Необходимо предоставить скан-копию или фотографию документа, подтверждающего факт участия в СВО	25 баллов
Категория «Прочие достижения»				50 баллов
7.	<p>Победитель, призер, лауреат или участник</p> <ul style="list-style-type: none"> - Международного или Всероссийского конкурса (выставки) научных и творческих работ, Всероссийский инженерный конкурс; - Международной или Всероссийской студенческой олимпиады (чемпионата); - Конкурса творческих и проектных работ МИЭТ; - Добровольного квалификационного экзамена от Правительства Москвы - др., соответствующих образовательной программе 	Портфолио	Необходимо предоставить скан-копию или фотографию документа (диплома, грамоты, сертификата), подтверждающего соответствующий статус в олимпиаде или конкурсе	до 40 баллов
8.	Письменное согласие организации о предоставлении места практики с указанием тематики профессиональной деятельности, соответствующей образовательной программе	Портфолио	Необходимо предоставить скан-копию или фотографию письменного согласия организации	10 баллов
9.	Очное участие в научно-технических конференциях, соответствующее образовательной программе	Портфолио	Необходимо предоставить скан-копию или фотографию документа, подтверждающего очное участие	2 балла

10.	Наличие научных публикаций, соответствующих образовательной программе: <ul style="list-style-type: none"> - опубликованные научные статьи в рецензируемых журналах, входящих в международные базы цитирования Web of Science и Scopus - опубликованные научные статьи в ведущих рецензируемых журналах из перечня ВАК - опубликованные статьи в журналах, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) - опубликованные тезисы/публикации без индексации (e-library) 	Портфолио	Необходимо предоставить скан-копию или фотографию следующих страниц сборника: титульный лист, оглавление, текст публикации, выходные данные.	до 20 баллов
11.	Патент по тематике образовательной программы	Портфолио	Необходимо предоставить скан-копию или фотографию патента	10 баллов

При поступлении в магистратуру учитываются ИД за 2023-2026 гг.

В п.7 учитываются конкурсы и олимпиады по тематике направления подготовки 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника». Комиссией устанавливается следующее соответствие (табл.2):

Таблица 2 — Начисление баллов за конкурсные мероприятия

Мероприятие	Статус «Победитель»	Статус «Призер»/ «Лауреат»	Статус «Участник»
Международный или Всероссийский конкурс (выставка) научных и творческих работ; Всероссийский инженерный конкурс; Международная или Всероссийская студенческая олимпиада (чемпионат)	30 баллов	15 баллов	2 балла
Конкурс творческих и проектных работ МИЭТ	30 баллов	15 баллов	0 баллов
Добровольный квалификационный экзамен от Правительства Москвы	10 баллов	5 баллов	0 баллов
Региональные и городские конкурсные мероприятия	10 баллов	5 баллов	0 баллов

При наличии конкурса, неподходящего под указанные пункты в табл.2, комиссия самостоятельно начисляет баллы. Суммарно за участие в конкурсах и олимпиадах можно получить не более 40 баллов.

В п.10 учитываются публикации по тематике направления подготовки 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника». Комиссией устанавливается следующее соответствие (табл.3):

Таблица 3 — Начисление баллов за конкурсные мероприятия

Публикация	Балл	Максимальный балл
журналы, входящие в международные базы цитирования WoS и Scopus	10	20
ведущие рецензируемые журналы из перечня ВАК (К1, К2)	10	20
ведущие рецензируемые журналы из перечня ВАК (К3)	5	15
журналы, включенные в РИНЦ	3	12
тезисы/E-library	2	6

Неопубликованные материалы оцениваются как «0 баллов». Суммарно за публикации можно получить не более 20 баллов.

ИД оцениваются экзаменационной комиссией в день прохождения поступающим вступительных испытаний. Оцениваются файлы ИД, загруженные посредством сервиса «Поступление в вуз онлайн» (портал «Госуслуг») не позднее чем за сутки до вступительного испытания.

3. ПОРЯДОК И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Вступительное испытание состоит из собеседования, включающего устный доклад поступающего, сопровождаемый презентацией в электронном и/или распечатанном виде, и устных ответов поступающего на вопросы комиссии по представленным в докладе материалам.

Даты, время и аудитории проведения вступительных испытаний назначаются в соответствии с Правилами приёма в федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» в 2026 году на обучение по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры.

Вступительное испытание проводится с использованием заранее подготовленной презентации, на устный доклад поступающего отводится 5-7 минут, на вопросы комиссии по представленным материалам и ответы поступающего отводится 8-10 минут.

Максимальное количество баллов, которое может получить поступающий по результатам вступительного испытания - 75 баллов. Максимальное количество баллов, набранных по совокупности вступительных испытаний и индивидуальных достижений – 125 баллов.

Экзаменационная комиссия по приему вступительных испытаний в течение одного дня после проведения собеседования оценивает ответы поступающих и передает протоколы с результатами вступительных испытаний в Приёмную комиссию.

4. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Презентация должна быть посвящена предыдущему опыту научно-исследовательской и/или проектно-конструкторской работы.

Рекомендуется следующая структура презентации:

- титульный слайд, содержащий заголовок «Основные результаты научной и практической деятельности», ФИО поступающего;
- краткие сведения об авторе: какое учебное заведение закончил, в каком году, по какому направлению/специальности;

- 3-4 слайда, посвященных выполненным ранее исследованиям/проектам и их результатам;
- слайд о предполагаемой тематике исследований в процессе обучения в магистратуре и возможном месте прохождения практики по данному направлению;
- 1-2 слайда с краткими сведениями об индивидуальных достижениях поступающего.

5. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

5.1 Критерии оценивания

Результаты собеседования оцениваются по следующим трём критериям:

- К.1 Научная и практическая значимость представленной работы – до 40 баллов,
- К.2 Качество устного доклада и оформления презентации – до 10 баллов,
- К.3 Качество ответов на вопросы – до 25 баллов.

Критерии оценки научной и практической значимости представленной работы представлены в Таблице 4.

Таблица 4 — Начисление баллов по критерию научной и практической значимости представленной работы

№ п/п	Критерий оценки	Максимальный балл
К.1.1	В докладе отражена актуальность представленных исследований/проектов	10
К 1.2	Результаты исследований содержат элементы научной новизны и/или позволяют получить новые научные результаты в ходе дальнейших исследований	15
К 1.3	Результаты выполненных проектов (проекта) обладают практической значимостью и/или могут быть внедрены на предприятиях отрасли	15

Критерии оценки качества устного доклада и оформления презентации представлены в Таблице 5.

Таблица 5 — Начисление баллов по критерию качества устного доклада и оформления презентации

№ п/п	Критерий оценки	Максимальный балл
К.2.1	В устном докладе за отведенное время логически стройно изложены все требуемые разделы презентации	5
К 2.2	Структура презентации содержит все необходимые разделы, аккуратно оформлена, слайды не перегружены материалом и хорошо читаются	5

Критерии оценки качества ответа на вопросы представлены в Таблице 6.

Таблица 6 — Начисление баллов по критерию качества ответов на вопросы

№ п/п	Критерий оценки	Максимальный балл
К.3.1	Получены развернутые ответы на все поставленные комиссией вопросы	15
К 3.2.	Ответы дополнены конкретными примерами, сравнением с литературными данными, с характеристиками известных промышленных изделий и/или технологий	10

Максимальный балл за вступительное испытание – 75 баллов.

5.2. Итоговая оценка

Итоговая оценка абитуриента определяется коллегиально членами экзаменационной комиссии на основании голосования простым большинством. При равном числе голосов голос председателя является решающим.

Результаты проведения вступительных испытаний оглашаются в день проведения вступительных испытаний по окончании собеседования посредством выставления баллов в списки поступающих, размещенных на сайте abiturient.ru, а также посредством ЕПГУ.

Приём вступительного испытания производится экзаменационной комиссией в соответствии с расписанием и списками абитуриентов, подготовленными Приёмной комиссией.

Директор Института ИнЭл


В.В. Лосев

Руководитель магистерской программы
«Проектирование и технология
устройств интегральной
наноэлектроники»


Ю.А. Чаплыгин

«16» января 2026 г.